

パワーモジュール組立・実装技術と最新動向

日時	2016年5月25日(水) 10:30~16:30 ※日程が変更になりました	主催	(株)R&D支援センター
会場	江東区産業会館 第2会議室 東京都江東区東陽4-5-18	定員	30名
受講料	49,980円 ※昼食・資料付	※満席になり次第、	
(税込)	※案内会員登録(無料)をしていただいた方には上記の割引・特典を適用します。 ・1名でお申込みされた場合1名につき47,250円 ・2名同時申込みでも会員登録をしていない場合は、計49,980円(2人目無料)です。 ※大学生、教員のご参加は、1名につき受講料10,800円です。 (ただし、企業在籍者は除きます。また、2人目無料も適用外です。)	※満席になり次第、	

このセミナーの 申込受付は終了しました

趣旨

近年、太陽光や風力発電などの創エネルギー分野やハイブリッド車や電気自動車による低炭素社会の実現がますます重要なものとなっている。これらの技術の中核を担うのが最新のパワーエレクトロニクス技術であり、高効率化、小型・軽量化に対する取り組みが鋭意されている。本講演ではこれらの技術の基幹部品であるパワー半導体モジュールに関して最新のIGBTモジュールとSiCモジュールについて説明するとともに、パッケージ組立・実装技術に対する課題と最新動向および今後の展開について述べる。

プログラム

1.はじめに

- 1-1 パワー半導体とは?
- 1-2 パワー半導体の動作
- 1-3 パワー半導体のアプリケーション
 - a) EV/EHV
 - b) 太陽光PCS,
 - c) 風力発電用コンバータ
 - d) 鉄道車両 など

2.最新Siパワーデバイスの詳細

- 2-1 第7世代IGBTモジュール
- 2-2 RB-IGBTモジュール(逆阻止形IGBT)
- 2-3 ハイブリッド型SiCモジュール
- 2-4 SiCモジュール

3.最新パッケージ・実装技術

- 3-1 低熱抵抗化技術
- 3-2 高放熱化技術
- 3-3 高パワー密度化技術
- 3-4 高信頼性技術

4.最新SiCパッケージ・実装技術

- 4-1 SiCパッケージに重要な特性
- 4-2 最新SiCパッケージの紹介

5.最新CAE技術

- 5-1 CAE技術の必要性
- 5-2 CAE技術の適用例

6.まとめ(今後の展開も含む)

『パワーモジュール組立・実装技術と最新動向』セミナー申込書

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	
お名前	所属	E-Mail	
①			
②			
案内会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。 ・お申込み後の連絡、受講証の発送、請求業務などは(株)R&D支援センターが行います。 ・Eメールまたは郵送でセミナー・書籍ののご案内をお送りします。 ・ご案内は(株)R&D支援センターおよびS&T出版(株)からお送りします。			
		<input type="checkbox"/> Eメール	<input type="checkbox"/> 郵送

※左記ご記入の上、**FAX 03-3261-0238**までお申込みください。

■お申込み方法
左記必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。お申込み後の連絡、受講証の発送、請求業務などは(株)R&D支援センターが行います。折り返し、R&D支援センターから受講証(当日ご持参下さい)、請求書、会場地図をご本人様宛てにお送り致します。お申込み後、5日以内にお手元に届かない場合は必ずR&D支援センター(TEL:03-5857-4811)へご一報下さい。

■お支払
請求書を発行いたしますので、開催日までに銀行振込でお願いいたします。

■個人情報の取り扱い
ご記入の個人情報は、当社および主催者が、事務連絡、ご案内等に使用いたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。